三(10分) 用0.2molYF₃加入到CaF₂中形成固溶体,试验测出该固溶体的晶胞参数 a_0 为0.55nm,密度 ρ = 3.64g/cm³,请写出该固溶体的缺陷反应。Y=88.90,Ca=40.08,F=19.00,CaF₂为萤石结构。 \rightarrow 大题36

四 (5分) 写出下列物质掺杂过程中的缺陷反应 →大题2

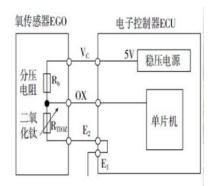
1) Al_2O_3 掺杂于MgO中 2) Y_2O_3 掺杂于 ZrO_2 中 3) Al_2O_3 掺杂于 TiO_2 中 4) UO_2 掺杂于 Y_2O_3 中 5)问在MgO 晶体中掺杂 10^{-9} 氧化铝杂质的情况下,当温度为多高时本征缺陷浓度大于由杂质引起的缺陷浓度。已知: MgO中的肖特基缺陷的生成能为 $9.612 \times 10^{-19} J$, $k=1.38 \times 10^{-23}$ 。

五(5分)请说明利用二氧化钛制备测量燃气炉中燃烧状况传感器的原理。

二氧化钛属于N型半导体材料,其电阻值随氧离子浓度(外界氧气浓度)的变化而变化,而废气中的氧气含量直接决定了燃烧过程的充分与否;此时的二氧化钛传感器在电路中相当于一个可变电阻,采用下面的接线方法,氧传感器上的分压即可反应燃烧的充分与否(燃烧充分,则原氧气过量,TiO2电阻低,信号电压小;反之则大)

六(5分)写出淌度的定义和三种表达式,说明传质与扩散的区别是什么?→大题35 扩散是分子或原子的微观扩散行为,传质是包括宏观流动和微观扩散行为的物质迁移。 扩散过程的推动力为<u>体系中存在的化学位梯度</u>,传质过程的推动力为<u>浓度差。</u>

七(10分)已知一个双层膜的厚度为L,双层膜中的扩散系数分别为 D_1 和 D_2 ,如果在膜的一个表面(x=0)处的扩散组元的浓度为 C_0 ,双层膜界面处的扩散组元浓度为 C_c ,膜的另一个表面(x=L)处的扩散组元浓度为 C_L , C_0 > C_C > C_L ,请证:扩散通量表达式为: $J=\frac{D_1(C_0-C_c)+D_2(C_c-C_L)}{L}$ →大题37

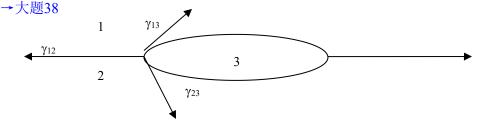


八 (10分) 已知,某一固相反应速度可由下式表述;

$$\frac{dx}{dt} = \frac{kR}{x(R-x)}$$

式中x、R、k分别为反应产物层厚度、固相颗粒原始半径、反应速度常数。假设反应率为 α =(反应物原始总量—t时刻反应物总量)/ 反应物原始总量。试求:分别经过多少时间后,反应率达到0.5 和1.3 →大题16

九(10分)下图所示分别为1、2、3相物质, γ_{12} 、 γ_{23} 和 γ_{13} 分别为1和2,2和3以及1和3相物质的界面自由能。请问什么条件下; 1)3相在1和2相之间界面铺展成薄膜,2)3相在1相中稳定分散,3)3相在2相中稳定分散。



十 (5分) 举例说明什么是局域能级? 局域能级对光吸收的影响。→大题3

十二、(15 分)解释: A)为什么氯化法制备金属钛时要添加碳? B)什么叫湿化学法? C)为什么采用氯化钠做氯化剂时必须采用 SO_3 气氛?

A) 作还原剂, $_{-TiO_2+Cl_2} \rightarrow \frac{1}{2} TiCl_4(g) + \frac{1}{2} O_2 \Delta G^{\theta} = 22050 - 6.9 T(kcal/mol)$,可见常温下 ΔG^{θ} 为正且值很大,说明常温下此反应很难

发生。 $TiO_2 + 2C + 2Glg$) = TiGl(g) + 2CO(g),此反应的摩尔标准吉布斯自由能变 $\Delta G^{\theta} = -5750 - 26.95T(kcal/mol)$,总为负值,说明在任何温度下都可反应。(但在室温下反应很慢)

- B) 有液相参加的、通过化学反应来制备材料的方法统称为湿化学法,如化学液相沉积(CBD)、电化学沉积(电镀)、溶胶凝胶等,氯化钠里氯是负一价, 氯气的氯是零价, 化合价升高, 是还原剂, 必须加氧化剂才能产生氯气
- C) NaC1是一种稳定的化合物,不能从别的化合物中夺走氧原子,给出C12; S03存在时由于形成Na2S04的自由能为很大的负值(即降低了反应自由能),可以夺走其他氧化物中的氧,用做氯化剂;此外,NaC1便宜且安全,故是一种理想的固态氯源。